

Тип ФР	U _{раб} , В	R _г , ом.	I _г , мка	I _{св} , мка	dI=I _{св} -I _г , мка	R _г /R _{св}	Удельная чувств., мка/лм-в	Интегральная чувствительн., а/лм	Мощность рассеяния, Вт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФСА-0	4-100	40*10 ³ -10 ⁶	-	-	-	1,2	500	-	0,01
ФСА-1	4-100	40*10 ³ -10 ⁶	-	-	-	1,2	500	-	0,01
ФСА-Г1	4-40	47*10 ³ -470*10 ³	-	-	-	1,2	500	-	0,01
ФСА-Г2	4-40	40*10 ³ -10 ⁶	-	-	-	1,2	500	-	0,01
ФСА-6	5-30	50-300*10 ³	-	-	-	1,2	500	-	0,01
ФСК-0	50	5*10 ⁶	10	2000	1990	200	7000	1,4	0,125
ФСК-1	50	5*10 ⁶	10	2000	1990	200	7000	1,4	0,125
ФСК-2	100	10*10 ⁶	10	800	790	80	1500	-	0,125
ФСК-4	50	5*10 ⁶	10	2000	1990	200	7000	1,4	0,125
ФСК-5	50	5*10 ⁶	10	1000	1990	100	6000	1,2	0,05
ФСК-6	50	3,3*10 ⁶	15	2000	1885	-	9000	1,8	0,2
ФСК-7а	50	10 ⁶	50	350	300	-	1500	-	0,35
ФСК-7б	50	10 ⁵	50	800	750	-	6000	1,2	0,35
ФСК-Г7	50	5*10 ⁶	10	2000	1990	200	3500	0,7	0,35
ФСК-Г1	50	5*10 ⁶	10	1500	1490	150	6000	1,2	0,12
ФСК-Г2	50	5*10 ⁶	10	4000	3990	400	12000	2,4	0,2
ФСК-П1	100	10 ¹⁰	0,01	1000-2000	1000-2000	-	4000	-	0,1
СФ2-1	15	30*10 ⁶	0,5	1000	1000	2000	400000	-	0,01
СФ2-2	2(10)	4*10 ⁶	0,5	1500	1500	3000	75000	-	0,05
СФ2-4	15	-	1,0	>750	-	-	-	-	0,01
СФ2-9	25	>3,3*10 ⁶	-	240-900	-	-	-	-	0,125
СФ2-12	15	>15*10 ⁶	-	200-1200	-	-	-	-	0,01
ФСД-0	20	20*10 ⁸	1	2000	2000	2000	40000	-	0,05
ФСД-1	20	20*10 ⁶	1	2000	2000	2000	40000	-	0,05
ФСД-Г1	20	20*10 ⁶	1	2000	2000	2000	40000	-	0,05
СФ3-1	15	15*10 ⁸	0,01	1500	1500	150000	600000	-	0,01
СФ3-8	25	-	<1	750	-	-	-	-	0,025

Полупроводниковые фотоэлементы - фоторезисторы обладают свойством менять свое активное сопротивление под действием падающего на них света. Фоторезисторы имеют высокую чувствительность к излучению в самом широком диапазоне - от инфракрасной до рентгеновской области спектра, причем сопротивление их может меняться на несколько порядков. Фоторезисторам присущи высокая стабильность во времени, они имеют небольшие габариты и выпускаются на различные номиналы сопротивлений. Наибольшее распространение получили фоторезисторы, изготовленные из сернистого свинца, сернистого кадмия, селенистого кадмия. Название типа фоторезисторов складывается из букв и цифр, причем в старых обозначениях буквы А, К, Д обозначали тип использованного светочувствительного материала, в новом же обозначении эти буквы заменены цифрами. Буква, стоящая за дефисом, при старом обозначении, характеризовала конструктивное исполнение (Г-герметизированные, П-пленочные). В новой маркировке эти буквы также заменены цифрами. В табл. 1 приведены наименования наиболее распространенных обозначений фоторезисторов.

ТИПОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФОТОРЕЗИСТОРОВ

Вид фоторезисторов	Старое обозначение	Новое обозначение
Сернисто-свинцовые	ФСА-0, ФСА-1, ФСА-6, ФСА-Г1, ФСА-Г2	
Сернисто-кадмиевые	ФСК-0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, ФСК-Г1, ФСК-Г2, ФСР;-Г7, ФСК-П1	СФ2-1, 2, 4, 9, 12
Селенисто-кадмиевые	ФСД-0, ФСД-1, ФСД-Г1	СФ3-1, 8